
	<h2 style="color: red;">SI5913DC-T1-GE3</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SI5913DC-T1-GE3</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET P-CH 20V 4A 1206-8</p> <p>Datenblätter:  SI5913DC-T1-GE3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 18578 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SI5913DC-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET P-CH 20V 4A 1206-8
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	18578 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	1.5V @ 250µA
Vgs (Max)	±12V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	1206-8 ChipFET™
Serie	LITTLE FOOT®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	84 mOhm @ 3.7A, 10V
Verlustleistung (max)	1.7W (Ta), 3.1W (Tc)
Verpackung	Cut Tape (CT)
Verpackung / Gehäuse	8-SMD, Flat Lead
Andere Namen	SI5913DC-T1-GE3CT
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	330pF @ 10V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	12nC @ 10V
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	Schottky Diode (Isolated)
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	2.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
detaillierte Beschreibung	P-Channel 20V 4A (Tc) 1.7W (Ta), 3.1W (Tc) Surface
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	4A (Tc)

SI5913DC-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI5913DC-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI5913DC-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SI5913DC-T1-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SI5908DC-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET 2N-CH 20V 4.4A 1206-8</p>	 <p>SI5913DC-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET P-CH 20V 4A 1206-8</p>	 <p>SI5915BDC-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2P-CH 8V 4A 1206-8</p>	 <p>SI5915BDC-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2P-CH 8V 4A 1206-8</p>
 <p>SI5915BDC-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET 2P-CH 8V 4A 1206-8</p>	 <p>SI5915BDC-T1-GE3 VISHAY VISHAY 1206-8</p>	 <p>SI5915BDC-T1-E3 Vishay Siliconix MOSFET 2P-CH 8V 4A 1206-8</p>	 <p>SI5913DC-T1-E3 Vishay Siliconix MOSFET P-CH 20V 4A 1206-8</p>

SI5913DC-T1-GE3 Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort	Electro-Films (EFI) / Vishay	SI5913DC-T1-GE3 Datenblatt	SI5913DC-T1-GE3-Datenblätter	SI5913DC-T1-GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SI5913DC-T1-GE3
SI5913DC-T1-GE3 Electronic	SI5913DC-T1-GE3-Komponenten	SI5913DC-T1-GE3-Verteiler	SI5913DC-T1-GE3-Bild	SI5913DC-T1-GE3 Teil	SI5913DC-T1-GE3 Inventar
SI5913DC-T1-GE3 Preis	SI5913DC-T1-GE3 Hersteller	SI5913DC-T1-GE3 garantiert	SI5913DC-T1-GE3 Bild	SI5913DC-T1-GE3 Aktie	SI5913DC-T1-GE3 Online bestellen
SI5913DC-T1-GE3 Neu	SI5913DC-T1-GE3 Original				

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited